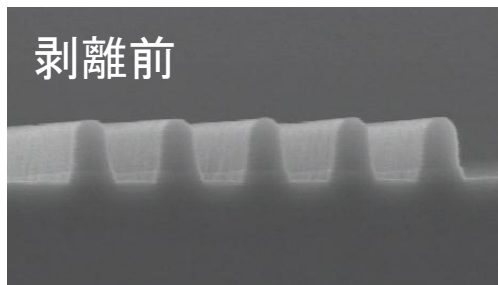


マイクロソリッドジェットによるレジスト剥離(加熱有り)

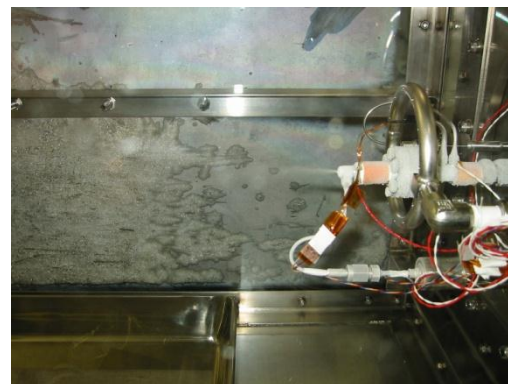


剥離前

1.5 μ m

Resist (500nm)/
Poly-Si (150nm)/
SiO₂ (6nm)/ Si

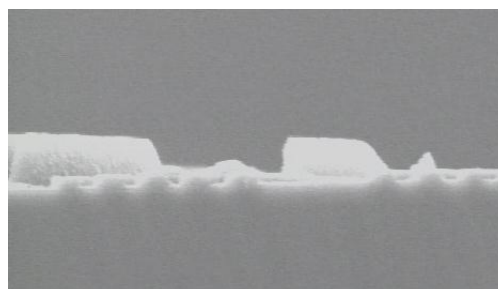
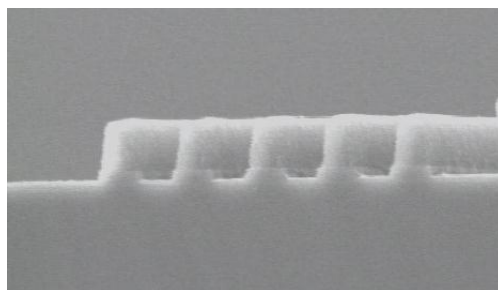
277°Cまで加熱後、
ソリッド噴霧
(約8sec後-200°C)



Sample-1 (15min噴霧)



Sample-2 (10min噴霧)



Sample-3 (5min噴霧)

